

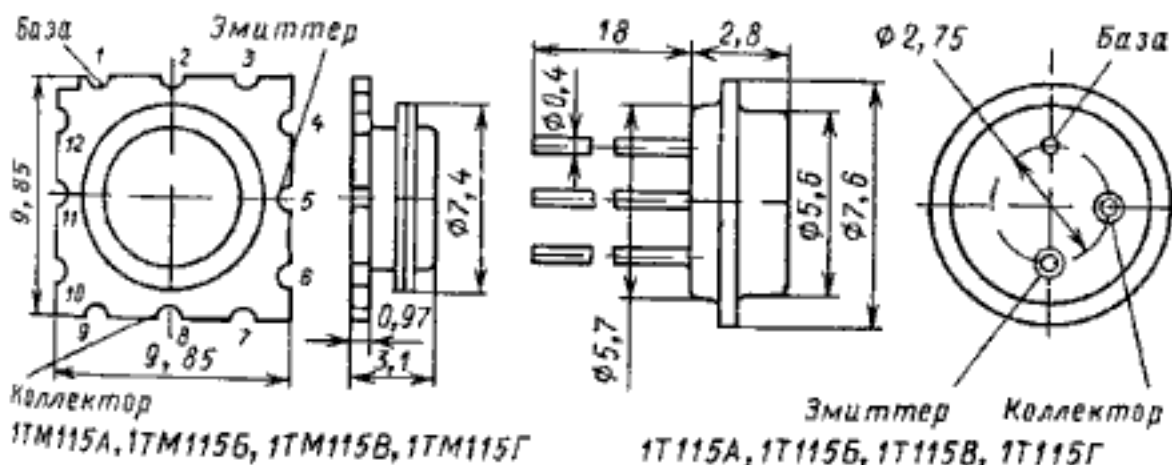
1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115А, 1Т115Б, 1Т115В, 1Т115Г

Транзисторы германиевые маломощные сплавные *p-n-p*

Предназначены для работы в усилительных и импульсных микромодулях этажерочной конструкции

Выпускаются в металлостеклянном корпусе на керамической плате (1ТМ115А – 1ТМ115Г) и с гибкими выводами (1Т115А – 1Т115Г) Обозначение типа приводится на корпусе транзистора

Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, с гибкими выводами не более 0,5 г



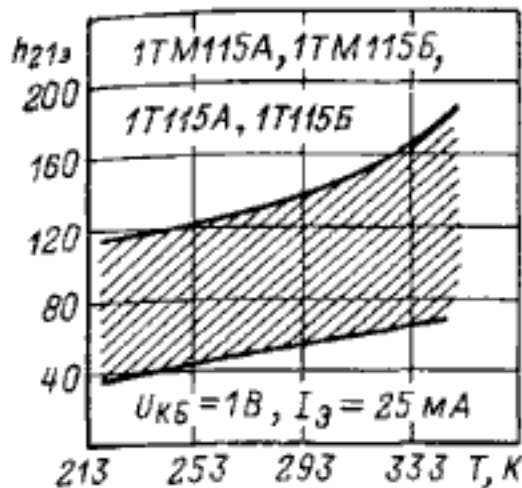
Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА не менее . . .	1 МГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 25$ мА	
1ТМ115А, 1ТМ115В, 1Т115А, 1Т115В	20–60
1ТМ115Б, 1ТМ115Г, 1Т115Б, 1Т115Г	50–150
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 100$ мА, $I_Б = 20$ мА не более	
1ТМ115А, 1ТМ115В, 1Т115А, 1Т115В	200 мВ
1ТМ115Б, 1ТМ115Г, 1Т115Б, 1Т115Г	150 мВ

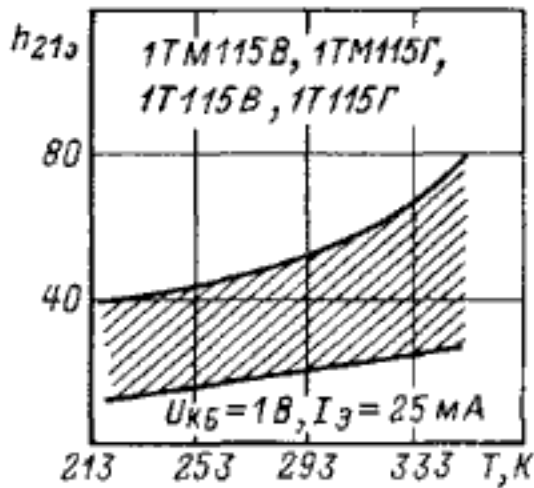
Напряжение насыщения эмиттер-база при $I_K = 100$ мА, $I_B = 20$ мА не более	1,5 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} \approx 5$ В, $f =$ $= 465$ кГц не более	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 5$ В, $f =$ $= 465$ кГц не более	20 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} =$ $= 5$ В, $I_Э = 1$ мА, $f = 465$ кГц не более	6,5 нс
Время рассасывания при $U_{КБ} = 15$ В, $I_K = 20$ мА не более	2,5 мкс
Граничное напряжение при $I_Э = 10$ мА	
1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б	30 В
1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115В, 1Т115Г	35 В
Обратный ток коллектора не более	
при $U_{КБ} = 50$ В, $T = 213 - 293$ К 1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б	50 мкА
при $U_{КБ} = 70$ В, $T = 213 - 293$ К 1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115В, 1Т115Г	50 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 50$ В не более . . .	50 мкА

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б	50 В
1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115В, 1Т115Г	70 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 500 \text{ Ом}$	
1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б	40 В
1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115В, 1Т115Г	55 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер	
1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б	50 В
1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115В, 1Т115Г	70 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
	50 В
Постоянный ток коллектора	
	100 мА
Постоянный ток базы	
	20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
при $T = 213 - 328 \text{ К}$	50 мВт
при $T = 346 \text{ К}$	20 мВт
Температура перехода	
	358 К
Температура окружающей среды	
	От 213 до 346 К



Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры



Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры